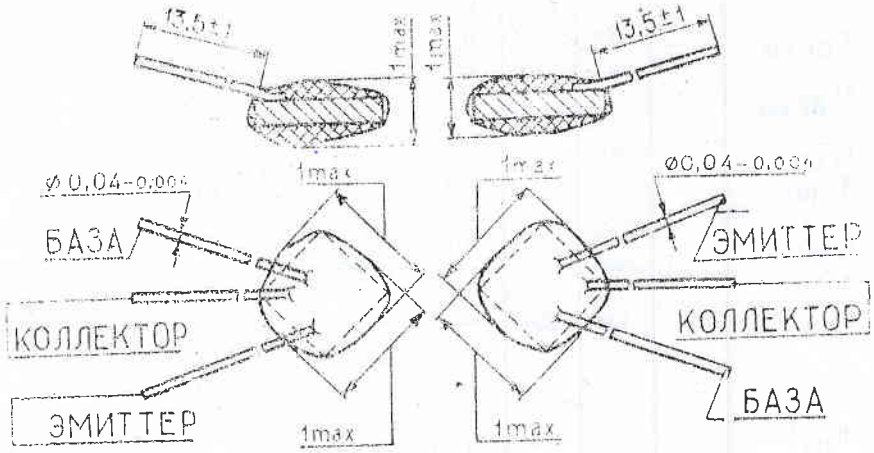
ЭТИКЕТКА

Наборы кристаллов транзисторов типа КТС395А-1, КТС395Б-1

Сделано в соответствии с ОСТ 11 336.025.81 и техническими условиями аА0.336.068 ТУ



Масса не более 10 мг

Содержание драгметаллов в 1 000 шт. кристаллов транзисторов золото 2,5838 г, палладий 0,0168 г

Дата изготовления транзисторов соответствует дате на этикетке

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, КТС395А-1 не менее	КТС395А-1 не более	КТС395В-1 не менее	КТС395В-1 не более
ПАРАМЕТРЫ ОДИНОЧНОГО ТРАНЗИСТОРА					
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при I_C =10 *мА*, I_B = 1 *мА*, *В*	$U_{CE\,sat}$		0,3		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер при I_C =10 *мА*, I_B = 1 *мА*, *В*	$U_{BE\,sat}$		1		1
Обратный ток коллектора при U_{CB} =45 *В*, *мкА*	I_{CBO}		0,5		
U_{CB} =10 *В*, *мкА*	I_{CBO}				0,05
Обратный ток эмиттера при U_{EB} =4 *В*, *мкА*	I_{EBO}		0,5		0,5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при U_{CB} =5 *В*, I_E =1 *мА*	h_{21E}	40	120	350	—
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при U_{CB} =5 *В*, I_E =10 *мА*, f = 100 *МГц*	$\lvert h_{21e} \rvert$	3		3	
Емкость коллекторного перехода при U_{CB} =10 *В*, f =10 *МГц*, *пФ*	C_c		8		8
ПАРАМЕТРЫ НАБОРА ТРАНЗИСТОРОВ					
Разность входных напряжений при U_{CB} =5 *В*, I_C =1 *мА*, *мВ*	$U_{BE1} - U_{BE2}$		10		—

з. 2011

conector.by